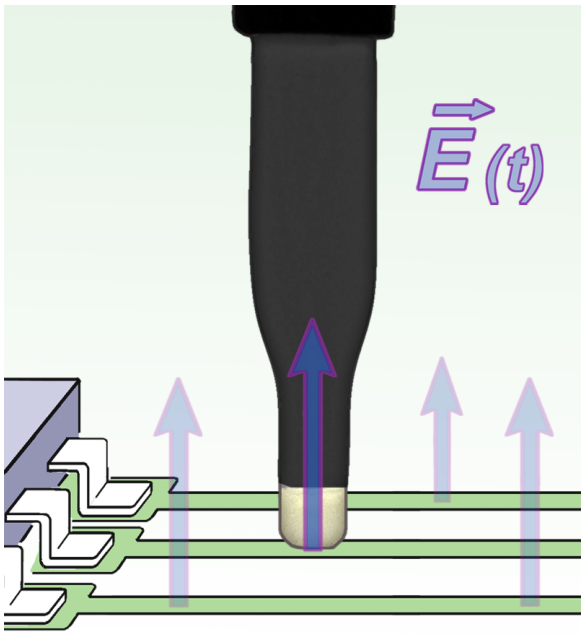
# RF-E 10

## E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz




### Kurzbeschreibung

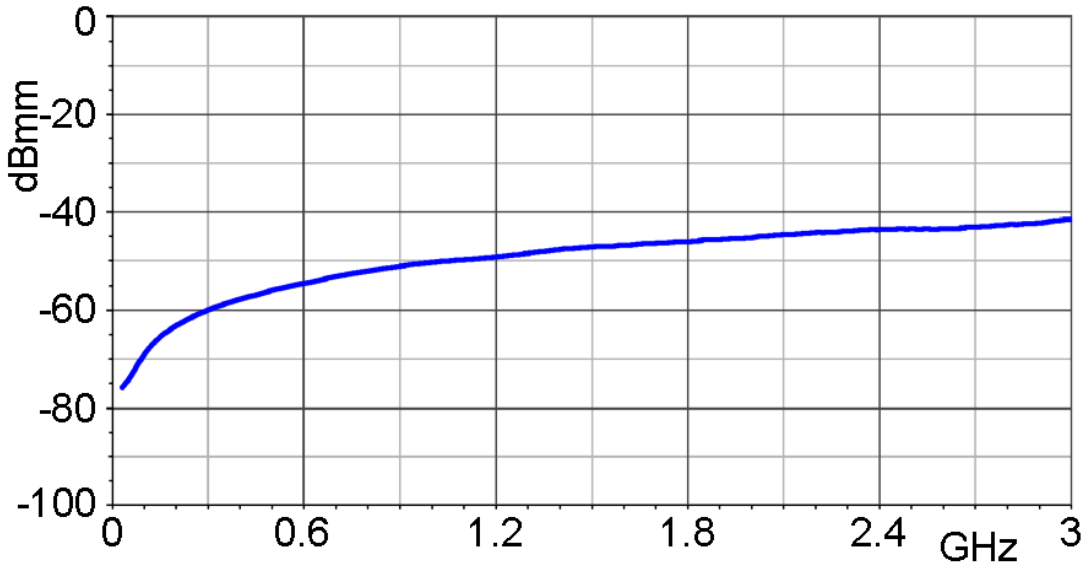
Die Elektrode an der Unterkante des Sondenkopfes der RF-E 10 ist ca. 0,2 mm breit. Damit können kleinste E-Feldquellen lokalisiert werden, z.B. 0,1 mm breite Leiterzüge, einzelne IC-Pins an hochpoligen ICs.

Die RF-E 10 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonden RF-E 05 und RF-E 02. Die Auflösung der RF-E 10 ist jedoch wesentlich höher. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Für Messungen in größeren Abständen wie sie mit der RF-E 05 und der RF-E 02 ausgeführt werden, ist sie nicht geeignet. Die E-Feldsonde ist klein und handlich. Sie besitzt eine Mantelstromdämpfung und die Oberseite des Sondenkopfes ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50 Ω Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern keinen 50 Ω Abschlusswiderstand.

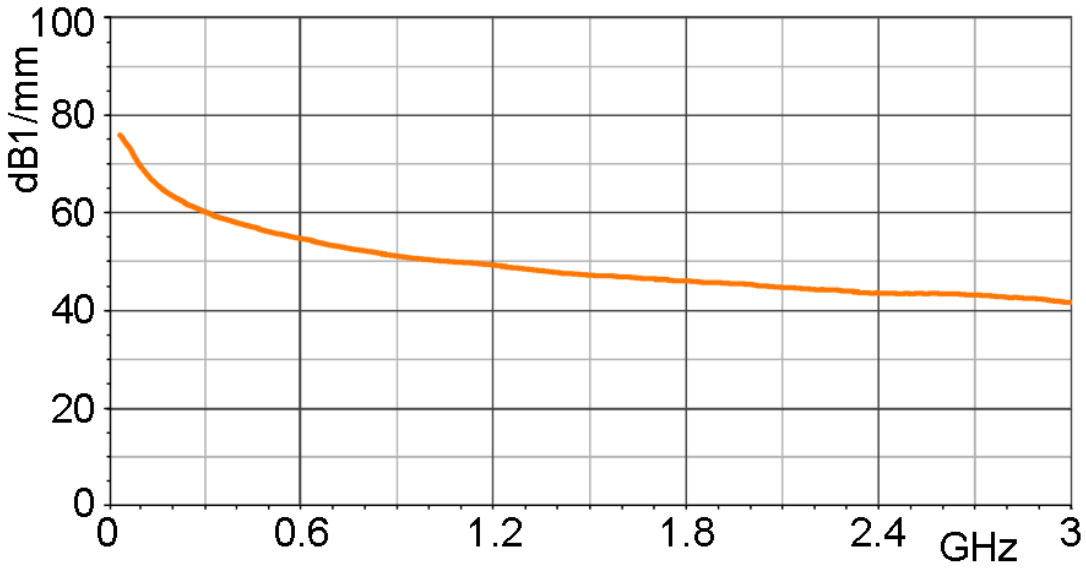
### Technische Parameter

| | |
|---|---|
| **Frequenzbereich** | 30 MHz ... 3 GHz |
| **Auflösung** | ≈ 0.2 mm |
| **Maße Sondenkopf:** | ≈ (0.5 x 2) mm |
| **Anschluss - Ausgang** | SMB, male, jack |
| **Gewicht** | 15 g |

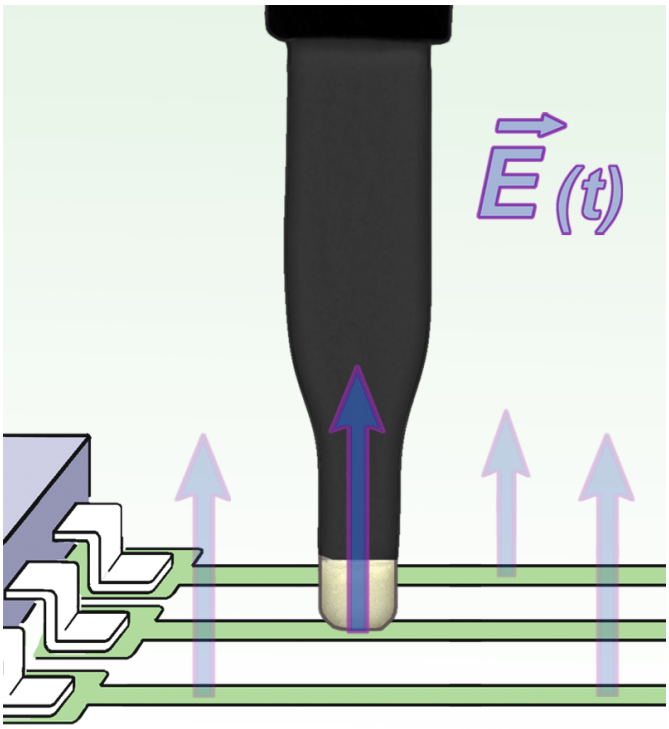
Frequenzgang [dBµV] / [dBµV/mm]




Korrekturkurve E-Feld [dBµV/mm] / [dBµV]



Messprinzip




Sondenkopf